

论坛四十五 (45). 信息存储材料论坛

分会主席: 宋志棠、吴华强、刘琦、周鹏、赵巍胜、杨玉超

单元 45-1: 10 月 10 日上午

主持人: 宋三年

地点: B3-09

8:30-8:35 开幕词

宋志棠

8:35-9:00 A45-01

DRAM 制造技术发展现状和未来展望

赵超

北京超弦存储器研究院

9:00-9:20 A45-02

高性能 1Kb SOT-MRAM 阵列的研制

刘宏喜

致真存储(北京)科技有限公司

9:20-9:40 A45-03

基于自旋轨道矩器件的可调人工神经网络

寇煦丰

上海科技大学

9:40-10:00 A45-04

基于阻变材料的存算融合智能计算

燕博南

北京大学

10:00-10:25 茶歇

10:25-10:45 A45-05

Atomic-level observation of $\text{Hf}_{0.5}\text{Zr}_{0.5}\text{O}_2$ thin films

成岩

华东师范大学

10:45-11:05 A45-06

铪基铁电阵列温度特性的机理及调控策略研究

龚天成

中国科学院微电子研究所

11:05-11:25 A45-07

新型铪基铁电材料与器件研究

魏莹芬

复旦大学

11:25-11:40 A45-08

面向可穿戴应用的卤素钙钛矿阻变存储器研究

王玉婵

天津理工大学

11:40-11:55 A45-09

集成电路材料基因组研究探索

李鑫

上海集成电路材料研究院

10 月 10 日下午

主持人: 宋三年

地点: B3-09

13:30-13:55 A45-10

高通量第一性原理计算集成实验加速相变材料研究

孙志梅

北京航空航天大学

13:55-14:15 A45-11

相变存储材料及其光电混合存储应用

刘波

苏州科技大学

14:15-14:35 A45-12

相变存储材料与器件的跨尺度模拟

张伟

西安交通大学

14:35-14:55 A45-13

基于相变材料的光子存内计算与关联学习芯片

程增光

复旦大学

14:55-15:15 A45-14

相变存储电控光算器件研发

周文

西安交通大学

15:15-15:40 茶歇

15:40-16:00 A45-15

新型硫系相变材料及其光子器件

吕业刚

宁波大学

16:00-16:15 A45-16

单质存储与开关新型器件

沈佳斌

复旦大学

16:15-16:30 A45-17

原子尺度观测相变材料微观结构转变过程

郑勇辉¹, 成岩¹, 宋志棠²

1.华东师范大学

2.中国科学院上海微系统与信息技术研究所

16:30-16:45 A45-18

基于分子构象转化的新型晶体管存储器的研究

郑磊

天津理工大学

16:45-17:00 A45-19

原子掺杂诱发多值存储效应机理探究

刘瑞蕊¹, 翟继卫², 宋三年³, 宋志棠³

1.上海应用技术大学

2.同济大学

3.中国科学院上海微系统与信息技术研究所